

装置名	主要な機能や仕様	その他特記事項	利用条件			担当者(内線)研究室名	詳細情報(ページ)
			利用形態	運転・保守費用	その他条件		

I. 試料の形成・加工・処理のための装置

1-1. 機械加工・研磨・5D成形など

ダイシング装置	φ 6"以下	材質・形状制約あり	自前利用 代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	17
研磨装置	シリコン 等	表面研磨専用	自前利用 代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	18
グルーピング装置	ボール研磨	不純物拡散深さ測定	自前利用 代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	18
3Dレーザースキャナ			条件付きで利用可	相談による		小林(784) 設計工学	19
積層成型機	STLデータからの3次元形状の造形	STLの準備は利用者の方でお願いします。	代行支援	有り	材料費:3から10万円程度/回	下田(782) 固体力学	20
真空成形機	樹脂の薄板成型(加工サイズ: W300xB300xH100mm程度)	型と材料の準備は利用者の方でお願いします。	代行支援	無し		下田(782) 固体力学	21

1-2. マイクロ・ナノ構造形成用プロセス

ワイヤボンダ(アルミ、金)	30μ mφ	超音波、熱圧着	自前利用 代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	22
スピンドーター	4000 rpm まで、プログラム可能	ドラフト内に設置	自前利用	無し	相談による	柳瀬(845) 界面制御プロセス	23
スピンドーター	レジスト塗布	10mm□~5"φ	自前利用 代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	24
スピンドーター	プログラマブル、小サンプル(φ 5mm)も可		自前利用 代行支援	相談による	相談による	吉村(851) 表面科学	なし
スピンドーター			自前利用	相談による	相談による	岡本(861) 高分子ナノ複合材料	なし
4源蒸着装置	金属蒸着用	利用後に、効果報告を頂きたい	自前利用 代行支援	講習を受けること、メンテナンス時に労働力を出してもらうこと	記帳すること	佐々木(840) 熊谷(843) マイクロカトロクス	25
抵抗加熱型真空蒸着装置	10 ⁻³ Pa	アルミニウム専用	自前利用 代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	26
プラズマCVD装置	カーボン材料(CNT)成長		代行支援	相談による	相談による	吉村(851) 表面科学	27
マグネトロンスパッタ装置	RF2元、DC2元、ターゲット2インチφ	多層膜作成可能	代行支援	相談による		栗野(873) 情報記録機能材料	なし
EB(電子ビーム)蒸着装置	10 ⁻³ Pa	Al, Ti, Ni, Fe等 Au蒸着不可	代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	28
電子線描画装置	最小寸法精度20nm	ワーク寸法4"φ フィールド寸法500μ m□	代行支援	相談による	講習参加者・経験者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	29
分子線エピタキシー装置	Ga, Al, In, As, Sb, Si-dope(n), C-dope(p)		代行支援	相談による	相談による	榎(706) 大森(702) ナノ電子工学	30
分子線エピタキシー装置	InGaAlAs, Si, Be-doping		代行支援	相談による	相談による	神谷(769) 量子界面物性	なし
マスクアライナー	解像度:0.75μ m アライメント精度:±0.5μ m		自前利用	相談による	相談による	榎(706) 大森(702) ナノ電子工学	31
マスク アライナー	最小寸法精度 5μ m	紫外線露光 g,h,i線	代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	32
マスク アライナー	最小寸法精度 5μ m	紫外線露光 g,h,i線	自前利用 代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	なし
パターンジェネレータ	最小寸法精度 5μ m	マスク作製	代行支援	相談による	講習参加者・経験者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	33

装置名	主要な機能や仕様	その他 特記事項	利用条件			担当者(内線) 研究室名	詳細情報 (ページ)
			利用形態	運転・保守費用	その他 条件		
フォトリピータ	最小寸法精度 5μ m	マスク作製	代行支援	相談による	講習参加者・ 経験者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	34
UVオゾン洗浄装置	オゾン分解処理機能付		自前利用	無し	相談による	柳瀬(847) 界面制御プロセス	35
UVオゾンクリーナー	付着有機物の洗浄		自前利用 代行支援	相談による	相談による	吉村(851) 表面科学	なし
プラズマ処理装置	DLC膜成膜可能(調整中)。 ウェハ最大3インチ。	利用後に、効果 報告を頂きたい	自前利用 代行支援	講習を受けること、 メンテナンス時に労 働力を出してもらう こと	記帳すること	佐々木(840) 熊谷(843) マイクロカトロクス	36
アッシング装置	有機物除去による表面クリー ニング。最大4インチウェハまで 入る。	利用後に、効果 報告を頂きたい	自前利用 代行支援	講習を受けること、 メンテナンス時に労 働力を出してもらう こと	記帳すること	佐々木(840) 熊谷(843) マイクロカトロクス	37
リアクティブイオンエッチ ング(RIE)装置	CF ₄ /O ₂ , SF ₆	シリコン専用	自前利用 代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	38
イオン打込み装置	150keV	有毒ガス使用 P ⁺ , B ⁺ , As ⁺	代行支援	相談による	講習参加者・ 経験者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	39

1-3. 化学合成・加熱処理・真空処理など

卓上マッフル炉	室温~1000°C, 大気中のみ昇 降温プログラム可能		自前利用 代行支援	無し	相談による(炉内を 汚損しないもの等)	荒川(867) 量子界面物性	40
アニール炉	最大800°C 真空下		代行支援	無し		栗野(873) 情報記録機能材料	なし
シンター炉	max.450°C	シリコン専用	代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	なし
小型オートクレーブ	水を溶媒・分散媒とする試料を 200°Cまで加熱可能。ガラス製 内筒、PTFE製内筒あり。	スターラーによる 攪拌可能	代行支援	無し	相談による	柳瀬(846) 界面制御プロセス	41
真空定温乾燥器	200°C程度まで		自前利用	無し	相談による	柳瀬(847) 界面制御プロセス	42
縦型拡散炉	max.1100°C	シリコン専用	代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	43
横型拡散炉	max.1100°C	シリコン専用	代行支援	相談による	講習参加者限定	梶原(560) 田村(562) クリーンルーム	44
小型ターボ分子ポンプ排 気装置				無し	相談による	柳瀬(847) 界面制御プロセス	45

1-4. その他

溶融押出機械			代行支援	無し	共同研究	田代(790) 極限高分子材料	なし
紡糸用加熱延伸装置			代行支援	無し	共同研究	田代(790) 極限高分子材料	なし
連続式2軸混練機/反応 装置(KRCニーダ)	混練装置		自前利用	相談による	相談による	岡本(861) 高分子ナノ複合材料	なし
成形機 (MiniMax MOLDER)	混練装置		自前利用	相談による	相談による	岡本(861) 高分子ナノ複合材料	なし
冷却粉碎器			自前利用	相談による	相談による	岡本(861) 高分子ナノ複合材料	なし
遠心機				無し	相談による	柳瀬(847) 界面制御プロセス	46